

**Hinweis:** Lösungsskizze. Fokus: Randbedingungen, Vorzeichen, Kerngleichungen.

### Aufgabe 1: Zustandsdichte und Trägerkonzentrationen

(a)  $g_C(E) \propto \sqrt{E - E_C}$  aus 3D-Zustandszählung ( $k$ -Kugel) und  $E - E_C \propto k^2$ .

(b) Boltzmann:

$$n = \int_{E_C}^{\infty} g_C(E) e^{-(E-E_F)/k_B T} dE = N_C e^{-(E_C-E_F)/k_B T}.$$

(c) Nicht-degeneriert:  $E_C - E_F \gtrsim 3k_B T$  (bzw.  $E_F - E_V \gtrsim 3k_B T$ ).

### Aufgabe 2: Dotierung mit Kompensation

(a) Neutralität:  $p + N_D = n + N_A$ . Mit  $p = n_i^2/n$ :

$$n^2 - (N_D - N_A)n - n_i^2 = 0.$$

(b) Lösung:

$$n = \frac{N_D - N_A}{2} + \sqrt{\left(\frac{N_D - N_A}{2}\right)^2 + n_i^2}, \quad p = \frac{n_i^2}{n}.$$

Physikalisch:  $n > 0$ , daher “+”-Wurzel.

(c) Grenzfälle: (i)  $|N_D - N_A| \gg n_i$ :  $n \approx N_D - N_A$  (n-Typ) und  $p \approx n_i^2/(N_D - N_A)$ . (ii)  $N_D \approx N_A$ :  $n \approx p \approx n_i$  möglich (nahe intrinsisch trotz großer Dotierungen).

### Aufgabe 3: Transport: Kontinuität und stationärer Fall

(a) Elektronen-Kontinuität (1D):

$$\frac{\partial n}{\partial t} = \frac{1}{q} \frac{\partial J_n}{\partial x} + G_n - R_n.$$

(b) Stationär,  $G_n = 0$ :

$$\frac{\partial J_n}{\partial x} = qR_n \quad (> 0 \text{ falls } R_n > 0).$$

(c)  $\partial J_n / \partial x > 0$ : Strom nimmt in  $+x$  zu; Interpretation: Nettoverlust an Elektronen durch Rekombination muss durch Stromdivergenz kompensiert werden.

(d) Mechanismen: SRH (Defekte) wichtig bei mittleren Trägerdichten/Defekten; Auger wichtig bei hohen Trägerdichten; radiativ wichtig in direkten Halbleitern.

### Aufgabe 4: p-n-Übergang: Feld, Potential, Kapazität

(a)

$$\rho(x) = \begin{cases} -qN_A, & -x_p \leq x \leq 0 \\ +qN_D, & 0 \leq x \leq x_n \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$$

(b) Aus  $dE/dx = \rho/\varepsilon_s$ , mit  $E(-x_p) = 0$ ,  $E(x_n) = 0$ :

$$E(x) = -\frac{qN_A}{\varepsilon_s}(x + x_p), \quad -x_p \leq x \leq 0, \quad E(x) = \frac{qN_D}{\varepsilon_s}(x - x_n), \quad 0 \leq x \leq x_n.$$

(c) Kontinuität bei  $x = 0$ :

$$N_A x_p = N_D x_n, \quad E_{\max} = \frac{q N_A x_p}{\varepsilon_s} = \frac{q N_D x_n}{\varepsilon_s}.$$

(d) Potential:

$$V_{bi} - V_a = \int_{-x_p}^{x_n} (-E) dx = \frac{q}{2\varepsilon_s} (N_A x_p^2 + N_D x_n^2).$$

(e) Mit  $W = x_p + x_n$ :

$$W = \sqrt{\frac{2\varepsilon_s}{q} \left( \frac{N_A + N_D}{N_A N_D} \right) (V_{bi} - V_a)}, \quad C' = \frac{\varepsilon_s}{W} \propto \frac{1}{\sqrt{V_{bi} - V_a}}.$$